



Transistor NPN de RF / 2-30 MHz / 12.5 Vcc / 12.5 W / Encapsulado 211-07

SKU: MRF433 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$255.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transistor NPN de silicio diseñado específicamente para aplicaciones de radiofrecuencia en el rango de alta frecuencia (HF). Opera eficientemente en el espectro de 2 a 30 MHz con una potencia de salida de 12.5 watts, ideal para etapas de potencia en transmisores, amplificadores de RF y equipos de comunicación. Su encapsulado estándar 211-07 facilita la integración en diseños existentes y nuevos desarrollos de equipos de telecomunicaciones.

Características principales

- Transistor NPN de silicio para aplicaciones RF
- Frecuencia de operación: 2 a 30 MHz
- Potencia máxima de salida: 12.5 watts
- Voltaje colector-emisor: 12.5 Vcc
- Encapsulado estándar 211-07 para montaje simplificado
- Alta eficiencia en operación de radiofrecuencia

Especificaciones técnicas

Tipo

Transistor de silicio NPN

Rango de frecuencia

2 - 30 MHz

Voltaje colector-emisor

12.5 Vcc

Potencia de salida

12.5 W

Encapsulado

211-07

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia en aplicaciones de radiofrecuencia
Característica 2	Rango de frecuencia optimizado para HF
Característica 3	Manejo de potencia de 12.5 watts continua
Característica 4	Voltaje colector-emisor de 12.5 Vcc
Característica 5	Encapsulado estándar para montaje simplificado
Característica 6	Silicio NPN para estabilidad térmica